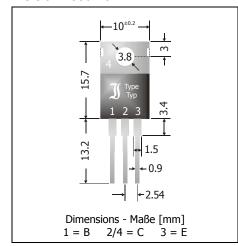


TIP120 ... TIP122

NPN Si-Epitaxial Planar Darlington Power Transistors Si-Epitaxial Planar Darlington-Leistungs-Transistoren

NPN

Version 2006-10-17



Max. power dissipation with cooling
Max. Verlustleistung mit Kühlung

Collector current
S A
Kollektorstrom

Plastic case
Kunststoffgehäuse

Weight approx.
Gewicht ca.

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging in tubes Standard Lieferform in Stangen



Maximum ratings $(T_A = 25^{\circ}C)$

Grenzwerte ($T_A = 25$ °C)

3 ()			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			TIP120	TIP121	TIP122
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spg.	B open	V_{CEO}	60 V	80 V	100 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spg.	E open	V_{CBO}	60 V	80 V	100 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EBO}	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung					
without cooling – ohne Kühlung with cooling – mit Kühlung	$T_A = 25$ °C $T_C = 25$ °C	P _{tot} P _{tot}	2 W ¹) 65 W		
Collector current – Kollektorstrom (dc)		\mathbf{I}_{C}		5 A	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		\mathbf{I}_{CM}		8 A	
Base current – Basisstrom (dc)		\mathbf{I}_{B}	120 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _S	-55+150°C -55+150°C		

Characteristics $(T_j = 25^{\circ}C)$

Kennwerte ($T_j = 25$ °C)

		Min.	Тур.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²)				
$I_C = 0.5$ A, $V_{CE} = 3$ V $I_C = 3$ A, $V_{CE} = 3$ V	h _{fe} h _{fe}	1000 1000		- -
Small signal current gain – Kleinsignal-Stromverstärkung				
$I_{C} = 3 \text{ A, } V_{CE} = 4 \text{ V, f} = 1 \text{ MHz}$	h_{fe}	4		

¹ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case Gültig wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

² Tested with pulses $t_p = 300~\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$ — Gemessen mit Impulsen $t_p = 300~\mu s$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$



Characteristics $(T_j = 25^{\circ}C)$

Kennwerte ($T_j = 25$ °C)

		Min.	Тур.	Max.
Collector-Emitter saturation volt. – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ²)				
I_C = 3 A, I_B = 12 mA I_C = 5 A, I_B = 20 mA	$\begin{matrix} V_{\text{CEsat}} \\ V_{\text{CEsat}} \end{matrix}$	_ _	_ _	2 V 4 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung ²)				
$I_C = 3 A$, $V_{CE} = 3 V$	V_{BE}	_	_	2.5 V
Collector-Emitter cutoff current – Kollektor-Emitter-Reststrom				
$V_{CE} = 30 \text{ V, (B open)}$ TIP120 $V_{CE} = 40 \text{ V, (B open)}$ TIP121 $V_{CE} = 50 \text{ V, (B open)}$ TIP122	$egin{array}{l} I_{ ext{CEO}} \ I_{ ext{CEO}} \ I_{ ext{CEO}} \end{array}$	- - -	- - -	500 nA 500 nA 500 nA
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom	•			
$V_{CB} = 60 \text{ V, (E open)}$ TIP120 $V_{CB} = 80 \text{ V, (E open)}$ TIP121 $V_{CB} = 100 \text{ V, (E open)}$ TIP122	$egin{array}{c} I_{\text{CBO}} \ I_{\text{CBO}} \ \end{array}$	- - -	- - -	200 nA 200 nA 200 nA
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
$V_{CB} = 10 \text{ V, } I_E = i_e = 0, f = 100 \text{ kHz}$	C _{CB0}	_	_	200 pF
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R _{thA}	< 63 K/W ¹)		
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse	R _{thC}	< 3 K/W		
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	M4	9 ± 10% lb.in. 1 ± 10% Nm		
Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren	TIP125 TIP127			
Equivalent Circuit – Ersatzschaltbild		B1 T1 T2 R1 R2 E2		

Tested with pulses t_p = 300 μ s, duty cycle \leq 2% - Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μ s, Schaltverhältnis \leq 2% Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden